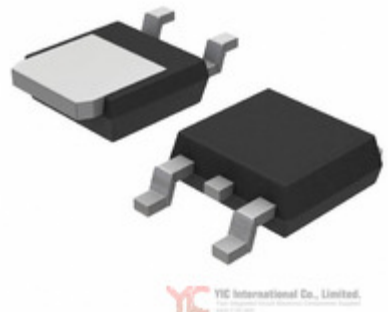

	<h2 style="color: #E67E22;">FCD360N65S3R0</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: FCD360N65S3R0
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: SUPERFET3 650V DPAK
	Datenblätter:  FCD360N65S3R0.pdf
	RoHs Status:
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	








Spezifikationen

Teilenummer	FCD360N65S3R0
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	SUPERFET3 650V DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 1mA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D-PAK (TO-252)
Serie	SuperFET® III
Rds On (Max) @ Id, Vgs	360 mOhm @ 5A, 10V
Verlustleistung (max)	83W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Andere Namen	FCD360N65S3R0-ND
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status	Lead free
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	730pF @ 400V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	18nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	650V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 650V 10A (Tc) 83W (Tc) Surface Mount D-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	10A (Tc)

FCD360N65S3R0 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FCD360N65S3R0-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FCD360N65S3R0 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FCD360N65S3R0 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FCD4A14CC ST ST DIP/20</p>	 <p>FCD2250N80Z Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 2.6A TO252-3</p>	 <p>FCD260N65S3 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 260MOHM TO252</p>	 <p>FCD3400N80Z Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 2A D2PAK</p>
 <p>FCD380N60E AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N CH 600V 10.2A DPAK</p>	 <p>FCD380N60E Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N CH 600V 10.2A DPAK</p>	 <p>FCD3400N80Z Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 2A D2PAK</p>	 <p>FCD4N60 Fairchi FCD4N60 Fairchi</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FCD360N65S3R0 AMI Semiconductor / FCD360N65S3R0 Datenblatt	FCD360N65S3R0-Datenblätter	FCD360N65S3R0 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FCD360N65S3R0
FCD360N65S3R0 Electronic	FCD360N65S3R0-Komponenten	FCD360N65S3R0-Verteiler	FCD360N65S3R0-Bild
FCD360N65S3R0 Preis	FCD360N65S3R0 Hersteller	FCD360N65S3R0 Bild	FCD360N65S3R0 Aktie
FCD360N65S3R0 Neu	FCD360N65S3R0 Original	FCD360N65S3R0 garantiert	FCD360N65S3R0 RFQ
			FCD360N65S3R0-Teil
			FCD360N65S3R0 Inventar
			FCD360N65S3R0 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited